

亚共晶铝硅合金细化剂 AI-V-B 的电弧快速制备及应用研究

冷强 赵朝邓 鲜勇*

成都大学机械工程学院 四川成都 610106

摘 要:采用氟盐法制备铝合金晶粒细化剂的传统工艺通常耗时较长,且会产生有害的环境排放物和残留物。为了探索新的细化剂制备方法,本文采用无氟原料通过电弧熔炼快速制备了Al-V-B细化剂,并验证了其在Al-10Si合金中的细化效果。在该中间合金中原位生成了 VB_2 、 AlB_2 和 AlB_{12} 三种不同的颗粒相。此细化剂对Al-10Si 合金表现出显著的晶粒细化能力,将初生 $\alpha-Al$ 晶粒尺寸从 2583 ± 386 μ m 大幅减小到 615 ± 169 μ m。

关键词: 铝合金; 硼化物; 铸造; 微观组织; 形核

引言

亚共晶铝硅合金因其优异的铸造性能、高比强度和低 成本,在汽车零部件及航空航天结构部件中得到了广泛应用 [1]。通常,亚共晶铝硅合金的铸态组织较为粗大,需要通过 晶粒细化剂进行改性[2,3]。然而,作为铝合金中最常见的细 化剂, Al-5Ti-1B 在硅含量较高(高于 3.5wt.%)的铝硅合 金中, 其晶粒细化效果会显著恶化^[4]。二硼化物(如 AIB,、 NbB2 和 VB₂)已被证明是亚共晶铝硅合金的有效细化剂, 能够成功抵抗所谓的"硅中毒"现象[5-9]。但是,由于硼在 铝熔体中的溶解度较低(659.7℃时为0.055at.%)^[10],直接 在略高于铝熔点的温度下通过熔体反应使用纯硼颗粒来生 产硼化物效率不高。即使以氟化盐 KBF4 的形式添加硼,也 通常需要在800-850℃的温度下反应数小时才能获得理想的 硼化物颗粒[9,11]。毫无疑问,氟盐工艺在工业生产中具有不 可替代的优势。然而,该方法在制备过程中不仅会不可避免 地产生有毒有害气体和废渣,而且耗时较长。因此,为了探 索快速的熔炼制备细化剂方法,本研究采用无氟原料通过电 弧熔炼快速制备了 Al-V-B 细化剂,并验证了其应用于亚共 晶 Al-10Si 合金的细化效果。

1 试验材料及方法

首先,将约10μm的AlV粉末(含40%的V,纯度99.9%)和约20μm的B粉末(纯度99.99%)在球磨机中混合10小时,然后压制成片。随后,将该片材和Al块(纯度99.99%)均置于电弧炉的水冷铜坩埚中,在氩气(纯度99.99%)保护下,以200A的电流和25V的电压进行2分钟的电弧熔炼。之后,将合金翻转,并再次执行相同的熔炼

操作。根据设计的中间合金成分(Al-5%V-5%B),将所获 得的细化剂称为 Al-5V-5B。在石墨坩埚中于 730℃下重新 熔化 Al-10Si 合金块后,将 Al-5V-5B 细化剂加入熔体中, 并使用石墨棒手动搅拌3分钟。最后,在去除浮渣和除气后, 将 700 $^{\circ}$ 的熔体浇铸到预热至 250 $^{\circ}$ 的 Φ 10 毫米石墨模具中, 该模具提供的冷却速率约为5℃/s,然后获得了含600ppm B 和 600ppm V 以及不含这些元素的 Al-10Si 锭。使用光学显 微镜 (OM, Zeiss Axio Imager A2m) 和带有能谱仪 (EDS) 的 场发射扫描电子显微镜 (SEM, Zeiss sigma 500) 对样品的 形貌、成分和微观结构进行分析。使用线性截距法测量晶 粒尺寸, 并使用 ImageJ 软件完成颗粒尺寸的统计。通过 X 射线衍射仪(XRD, Bruker D8 Advance)进行相鉴定。通过 差示扫描量热仪(DSC, Netzsch STA 449F3)在氩气保护下 以 10℃ /min 的加热和冷却速率测定添加细化剂前后 Al-10Si 凝固的过冷度。采用 HBE-3000M 布氏硬度计测量试样的硬 度, 压球直径 10mm, 加载载荷 1000kg, 保载时间 15s。使 用 GF-1 型往复式摩擦磨损试验机在环境温度下进行摩擦磨 损测试。对磨副为直径 5mm 的 GCr15 陶瓷球,载荷 10N, 往复频率 3Hz, 磨损轨迹长度为 5 mm, 摩擦时间 30 min。 使用 VHX-7000 三维数字显微镜测量磨损体积, 然后计算 体积磨损率。

2 结果与讨论

2.1 物相及微观组织分析

图 1 所示,为通过快速电弧熔炼制备的中间合金 Al-5V-5B 的 XRD 图谱,从中可以分别观察到 α -Al、VB₂、AlB₂和 AlB₁₂的特征衍射峰。根据 XRD 物相分析结果并



和图 2 中的 EDS 成分分析结果相结合,可以确定嵌入在 Al 基体中的三种不同颗粒相,即具有不规则多边形形态 的粗大的深灰色相、浅灰色针状析出物和小白色颗粒,分别为 AlB₁₂、AlB₂和 VB₂。此外,其平均颗粒尺寸按 AlB₁₂>AlB₂>VB₂的顺序逐步减小,分别为 $16.7\pm8.6\mu$ m、 $9.2\pm7.4\mu$ m 和 $1.0\pm0.7\mu$ m (图 3)。其中,VB₂和 AlB₂的尺寸与通过传统氟盐法制备的相应产物相似 ^[8]。此外,可以清楚地看到,颗粒数量按 VB₂、AlB₁₂和 AlB₂的顺序减少,且 VB₃颗粒的数量远多于其它两种物相。

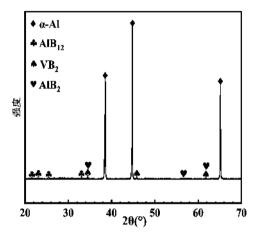


图 1 AI-5V-5B 的 XRD 图谱

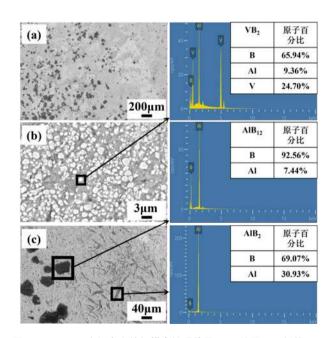


图 2 Al-5V-5B 中间合金的扫描电镜照片及 EDS 结果: (a) 低倍, (b) 和 (c) 高倍

尽管很难准确测量电弧熔炼过程中熔体的温度,但仍然可以大致从 Al-B 和 V-B 二元相图 $^{[10,12]}$ 中推断出熔体的凝固路径。在冷却过程中,VB₂ 首先在 2068 ℃时形成。其次,AlB₁₂ 在 2050 ℃时形成,最后在 1030 ℃时,AlB₁₂ 开始转变为 AlB₂。这也是为什么 AlB₂ 在所有析出相中数量最少的原因,因为本研究中使用的水冷铜坩埚的快速冷却冻结了 AlB₁₂ 到 AlB₂ 的转变。此外,这一凝固路径表明,熔体局部所经历的温度至少不低于 2068 ℃。与在 800 ℃下通过 V+KBF4 工艺制备 Al-V-B 晶粒细化剂 $^{[8]}$ 相比,除了 AlB₂ 和 VB₂外,本研究还显示出 AlB₁₂ 相的存在,未观察到 Al3V 等钒铝金属间化合物析出。Al3V 等相的缺失可以归因于熔炼温度远高于 800 ℃,这加速了熔体中 V 溶质的扩散,并促进了其与 B 溶质的充分反应以形成 VB₂。在本研究中,当 B 与 V 的质量比为 1:1 (摩尔比约为 5:1) 时,熔体中剩余的 V 溶质在合成 VB₂后不足以析出为 Al_3 V 等钒铝中间相。

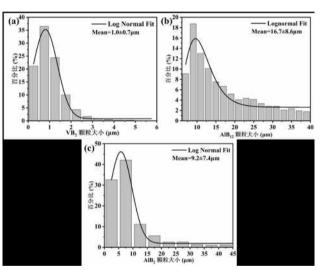


图 3 Al-5V-5B中间合金的颗粒尺寸分布曲线 (a) VB_2 , (b) AlB_{12} , (c) AlB_2

2.2 细化效果

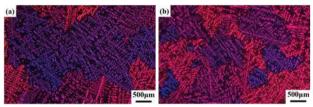


图 4 Al-10Si 合金的光学显微组织(a)细化前,(b)细化后

图 4 展示了添加细化剂前后 Al-10Si 合金的金相组织对比。显然,添加 Al-5V-5B 中间合金显著地将 $\alpha-Al$ 的晶粒



尺寸从 2583 ± 386 μm 减小到 615 ± 169 μm,表现出了明显的细化效果。根据 Greer等人 [13] 提出的公式,可以计算出单位体积内的晶粒数量从 2.9 × 10°/m³ 变为 2.9 × 10°/m³,几乎增加了两个数量级。在相同的冷却条件下,晶粒数量的急剧增加意味着与参照样相比,通过添加 Al-5V-5B 进行细化的合金中引入了更多的异质形核点。

2.3 差热分析

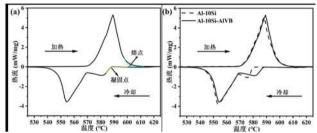


图 5(a) 正切法确定熔点及凝固点的示意图, (b) Al-10Si 合金添加 Al-5V-5B 细化剂前后的 DSC 曲线

表 1 图 5 中 DSC 曲线中的熔点、凝固点以及过冷度

	Al-10Si	Al-10Si-AlVB
熔点 /℃	599.4	601.9
凝固点 /℃	579.8	588.1
过冷度 /℃	19.6	13.8

热分析已被证明是评估晶粒细化剂细化效率的有力手 段[6.7.9]。在本研究中,通过采用切线法(如图5所示)测量 DSC 曲线,确定了加热过程中的熔化温度和冷却过程中的 凝固温度,从而可以通过两者之差计算出过冷度。理论上, 异质形核的存在将大大降低形核能垒, 导致 α-Al 形核所需 的过冷度显著降低。因此, 过冷度的降低可以作为添加的 中间合金诱导 α-Al 异质形核的确凿证据。值得一提的是, 在加热过程中仅出现一个吸热峰,而在冷却过程中出现两个 放热峰(即 α-Al 析出和共晶组织凝固)。这与文献 [14] 中 的 DSC 曲线一致,表明在近共晶成分点附近,加热过程中 的两个吸热峰会相互重叠。从表1中可以看出,添加中间 合金的 Al-10Si 样品的过冷度为 13.8℃,远低于未添加 Al-V-B 的参照样的 19.6℃。这与 Greer 等人 [13] 提出的自由生 长模型一致, 并完全证实了 Al-5V-5B 细化剂为 α-Al 提供 了异质形核位点,从而细化了晶粒。众所周知,有效的异质 形核剂不仅需要良好的热稳定性,还需要与 Al 的晶格失配 度小。由于 AB12 与 α -Al 的晶格失配度高达 151%, 因此 AB12 可以被排除在有效的异质形核基底之外[15]。相比之下,

如 Zhao 的工作^[8] 中所述, AlB, 和 VB, 都与 α-Al 表现出良 好的晶格匹配(即原子错配度 fr<10%)。因此,这两种颗 粒可以作为 α-Al 的潜在形核位点, 这也被其它实验和研究 [9,15,16] 反复证实。与 Zhao 的研究 [8] 相比,细化剂同样添加 600 ppm V 和 600 ppm B 到 Al-Si 合金中,将 α-Al 晶粒从 1736 μm 细化到 184 μm, 展现出比本研究结果更小的细化 尺寸。然而, 值得一提的是, 他们的冷却速率约为 30°C/s, 远高于本研究中的冷却速率(约5°C/s),这本身有利于增 强晶粒细化效果。这可以通过比较未添加 Al-V-B 的参照样 的原始晶粒尺寸来确认,即 1736 μm 也远低于本研究中的 对应值(2583 μm)。此外,这也可以很好地用 Greer 等人[13] 提出的自由生长模型来解释,即基底尺寸和过冷度在新晶粒 的形成中都起着重要作用。具体来说,较低的过冷度有利于 较大的颗粒成为活性形核剂,反之亦然。因此,由较高的冷 却速率(约30℃/s)引起的更大过冷度有利于更多的小颗 粒作为活性形核剂,尤其是 VB2,其数量在 Al-5V-5B 中间 合金中占小颗粒的绝大多数, 因此可以预期 α-Al 晶粒尺寸 会有更大幅度的减小。实验结果表明,在不使用 KBF4 的情 况下,通过快速电弧熔炼制备晶粒细化剂是可行的,并且未 来仍有许多内容需要进一步研究,如优化熔炼参数、冷却速 率、V:B比例等,以实现对亚共晶Al-Si合金更好的细化效果。

3 结论

本研究提出了采用快速电弧熔炼法制备用于 Al-10Si 亚 共晶合金的晶粒细化剂 A-V-B。与氟盐法生产的相应产品 相比,本研究中的 A-V-B 中间合金观察到了 AB_2 、 VB_2 和 AB_{12} 相的存在,没有钒铝中间化合物的形成。实验结果表明, Al-V-B 中间合金对 $\alpha-Al$ 校晶具有显著的细化效果,将晶粒尺寸从 2583 ± 386 μ m 减小到 615 ± 169 μ m。 AB_2 和 VB_2 相作为有效的异质形核位点,显著促进了 $\alpha-Al$ 的形核和细化。

参考文献:

[1]Hearn W, Bogno A A, Spinelli J, et al. Microstructure Solidification Maps for Al–10 Wt Pct Si Alloys[J].Metallurgical and Materials Transactions A, 2019(50):1333–1345.

[2]Jiang B, Jiang B, Yang W, et al. Efficient modification eutectic Si of Al-10Si alloy with Mg-Gd master alloy addition[J]. Materials Letters,2024(361): 136071.

[3]Kori S A, Murty B S, Chakraborty M. Development of an



efficient grain refiner for Al–7Si alloy and its modification with strontium[J].Materials Science and Engineering: A,2000(283): 94–104.

[4]Li Y, Hu B, Liu B, et al. Insight into Si poisoning on grain refinement of Al-Si/Al-5Ti-B system [J]. Acta Materialia, 2020(187): 51-65.

[5]Z Chen, H Kang, G Fan, et al. Grain refinement of hypoeutectic Al-Si alloys with B[J]. Acta Materialia, 2016 (120): 168-178.

[6]Nowak M, L Bolzoni, N Hari Babu. Grain refinement of Al-Si alloys by Nb-B inoculation. Part I: Concept development and effect on binary alloys[J].Materials & Design, 2015 (66): 366– 375.

[7]Bolzoni L, M Nowak, N Hari Babu. Grain refinement of Al-Si alloys by Nb-B inoculation. Part II: application to commercial alloys[J].Materials & Design, 2015(66): 376-383.

[8]Zhao C, Li Y, Xu J, et al. Enhanced grain refinement of Al-Si alloys by novel Al-VB refiners[J]. Journal of Materials Science & Technology, 2021 (94): 104-112.

[9]Zhang Y H, Ye C Y, Shen Y P, et al. Grain refinement of hypoeutectic Al-7wt.% Si alloy induced by an Al-V-B master alloy[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2020(812): 152022.

[10]Duschanek H, Rogl P. The Al-B (aluminum-boron) system[J]. Journal of Phase Equilibria, 1994 (15): 543–52.

[11]Bolzoni L, Nowak M, Babu N H. Grain refining potency of Nb–B inoculation on Al–12Si–0.6 Fe–0.5 Mn alloy[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2015(623): 79–82.

[12]Spear K E, Liao P K, Smith J F. The B-V (Boron-Vanadium) system[J].Journal of Phase Equilibria,1987(8): 447–454.

[13] Greer A L, Bunn A M, Tronche A, et al. Modelling of inoculation of metallic melts: application to grain refinement of aluminium by Al-Ti-B[J]. Acta Materialia, 2000 (48): 2823–2835.

[14] 孙玉成,郑洪亮,吴淑霞,等. 铝硅合金潜热变化规律的 DSC 分析 [J]. 山东大学学报 (工学版),2011(41): 132-137.

[15]Nafisi S, Ghomashchi R. Boron-based refiners: implications in conventional casting of Al-Si alloys[J].Materials Science and Engineering: A,2007(452-453): 445-453.

[16]Birol, Y. AlB3 master alloy to grain refine AlSi10Mg and AlSi12Cu aluminium foundry alloys[J].Journal of Alloys and Compounds, 2012(513): 150–153.

作者简介:

冷强(1999—),男,汉,四川省资阳市,硕士研究生,成都大学,研究方向:主要从事铝合金方向的研究。

通讯作者:鲜勇(1983—),男,教授,主要从事机械工程材料研究。